

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成29年2月23日 (2017.2.23)

【公開番号】特開2015-141255(P2015-141255A)

【公開日】平成27年8月3日 (2015.8.3)

【年通号数】公開・登録公報2015-049

【出願番号】特願2014-12823(P2014-12823)

【国際特許分類】

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

G 0 9 G 3/30 (2006.01)

G 0 9 G 3/20 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 1 L 27/32 (2006.01)

H 0 5 B 33/02 (2006.01)

【 F I 】

G 0 9 F 9/30 3 3 8

G 0 9 G 3/30 J

G 0 9 G 3/20 6 2 4 B

G 0 9 G 3/20 6 8 0 G

G 0 9 G 3/20 6 2 1 M

H 0 5 B 33/14 A

G 0 9 F 9/30 3 6 5

H 0 5 B 33/02

【手続補正書】

【提出日】平成29年1月12日 (2017.1.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板と、

前記基板の上側に、第 1 チャネル部を含んで形成された第 1 半導体層と、

前記基板の上側に、第 1 容量電極を含んで形成された第 2 半導体層と、

前記第 1 半導体層及び前記第 2 半導体層の上側に形成された第 1 絶縁層と、

前記第 1 絶縁層の上側に、第 1 ゲート電極の一部と、第 2 容量電極の一部と、を含んで形成された第 3 半導体層と、

前記第 3 半導体層の上側に形成された第 2 絶縁層と、

前記第 2 絶縁層の上側に形成された、有機 E L 発光素子のアノード電極と、

を含み、

前記第 1 チャネル部、前記第 1 絶縁層及び前記第 1 ゲート電極は、駆動トランジスタの一部を構成し、

前記第 2 半導体層、前記第 1 絶縁層及び前記第 2 容量電極は、第 1 容量の少なくとも一部を構成し、

前記第 3 半導体層は、平面視において、前記第 1 絶縁層、前記第 1 半導体層及び前記第 2 半導体層と重畳し、

前記アノード電極は、平面視において、前記第 1 絶縁層及び前記第 1 乃至第 3 半導体層

と重畳する、

ことを特徴とする発光素子表示装置。

【請求項 2】

前記第 2 絶縁層と前記アノード電極の間にそれぞれ形成された第 3 容量電極及び走査信号線をさらに含み、

前記第 2 絶縁層は、前記第 3 半導体層と前記アノード電極の間に配置され、

前記第 3 容量電極は、前記第 2 半導体層と電氣的に接続され、

前記走査信号線は、第 2 ゲート電極を含み、

前記第 3 半導体層は、第 2 チャンネル部を含み、

前記第 3 半導体層、前記第 2 絶縁層及び前記第 3 容量電極は、前記第 1 容量の少なくとも一部を構成し、

前記第 2 チャンネル部、前記第 2 絶縁層及び前記第 2 ゲート電極は、画素トランジスタの一部を構成する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の発光素子表示装置。

【請求項 3】

前記第 3 容量電極は、平面視において、前記第 1 絶縁層、前記第 1 半導体層及び前記第 2 半導体層と重畳し、

前記アノード電極は、平面視において、前記第 3 容量電極と重畳し、

前記画素トランジスタは、平面視において、前記アノード電極の外側に配置された領域を含む、

ことを特徴とする請求項 2 に記載の発光素子表示装置。

【請求項 4】

前記第 3 容量電極及び前記走査信号線の上側に形成された第 3 絶縁層と、

前記第 3 絶縁層の上側に形成された高基準電位線と、

をさらに含み、

前記高基準電位線は、平面視において、前記第 2 半導体層、前記第 3 半導体層及び前記第 3 容量電極のそれぞれの一部と重畳し、

前記高基準電位線は、前記駆動トランジスタと電氣的に接続される、

ことを特徴とする請求項 3 に記載の発光素子表示装置。